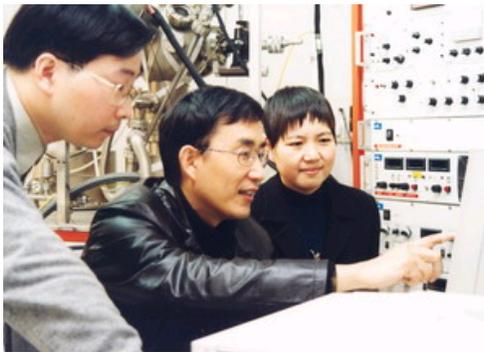


您现在的位置: 首页>新闻中心>新闻快递

“高端硅基SOI材料研发和产业化”项目喜获国家科技进步一等奖 07.02.26

2007年02月27日 浏览次数



日前, 2006年度国家科学技术奖评选结果在京揭晓, 我所“高端硅基SOI材料研发和产业化”项目获得了2006年度国家科技进步奖一等奖。此次国家科学技术进步奖一等奖有11项, 二等奖173项。“高端硅基SOI材料研发和产业化”项目的主要完成人为: 王曦, 林成鲁, 张苗, 陈猛, 俞跃辉, 张峰, 李炜, 宋志棠, 张正选, 刘卫丽, 王连卫, 林梓鑫, 陈静, 李守臣。

这是我所作为第一完成人和上海新傲科技有限公司共同实现了国家科技进步一等奖的零突破; 是自进入知识创新一期、二期试点工程以来, 经过广大科技人员的共同努力, 围绕着系统带器件, 器件带材料的办所理念, 实现了我所转型以来系统、器件、材料三个层面全方位的重大突破; 也是继60年代“甲种分离膜”以来, 我所通过知识创新工程, 广大科研人员不断更新观念, 围绕着国家的战略需求, 锐意进取, 勇攀科技高峰所取得的又一重大成果“集群”。